



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

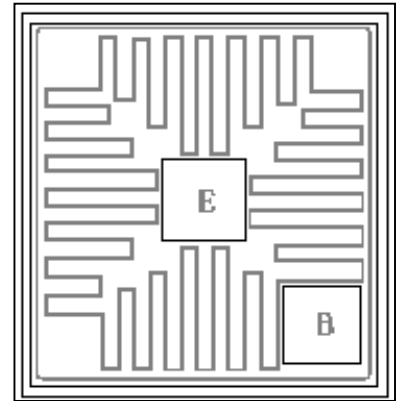
HD965

对应国外型号
2SD965

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：C089AJ-00-XXX
芯片厚度： $240 \pm 20\mu\text{m}$
管芯尺寸： $890 \times 890\mu\text{m}^2$
焊位尺寸：B 极 $230 \times 230\mu\text{m}$ ；E 极 $170 \times 170\mu\text{m}$
电极金属：铝
背面金属：金
封装形式：TO-92

芯片图



极限值 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

T_{stg} ——贮存温度..... -55~150
 T_j ——结温..... 150
 P_C ——集电极耗散功率..... 0.75W
 V_{CBO} ——集电极—基极电压..... 40V
 V_{CEO} ——集电极—发射极电压..... 20V
 V_{EBO} ——发射极—基极电压..... 7V
 I_C ——集电极电流..... 5A

电参数 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			100	nA	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$, $I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			100	nA	$V_{\text{EB}}=7\text{V}$, $I_C=0$
V_{CEO}	集电极-发射极电压	20			V	$I_C=1\text{mA}$, $I_B=0$
V_{EBO}	发射极-基极电压	7			V	$I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$
h_{FE1}	直流电流增益	180		800		$V_{\text{CE}}=2\text{V}$, $I_C=0.5\text{A}$
h_{FE2}	直流电流增益	150				$V_{\text{CE}}=2\text{V}$, $I_C=2\text{A}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压			1	V	$I_C=3\text{A}$, $I_B=0.1\text{A}$
f_T	特征频率	150			MHz	$V_{\text{CB}}=6\text{V}$, $I_E=50\text{mA}$
C_{ob}	共基极输出电容			50	pF	$V_{\text{CB}}=20\text{V}$, $I_E=0$, $f=1\text{MHz}$